

ウエハ・チップの特定箇所の前処理技術

目的箇所のみサンプリングし、ウエハを割らずにサンプル作製します

測定法 : EDX・EELS・TEM・FIB

製品分野 : LSI・メモリ

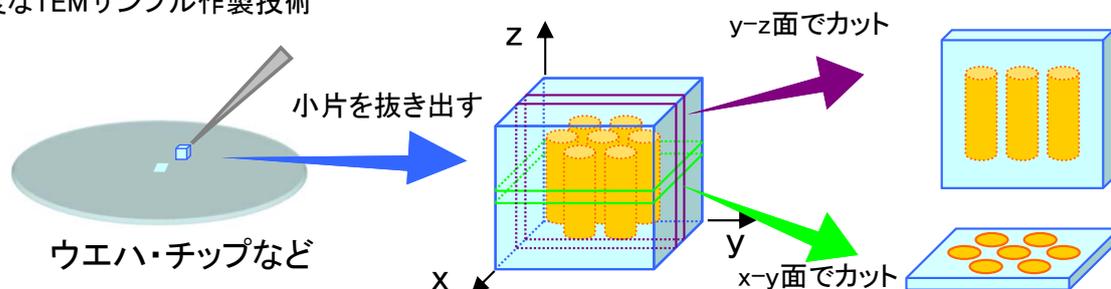
分析目的 : 組成評価・同定・組成分布評価・形状評価・構造評価

概要

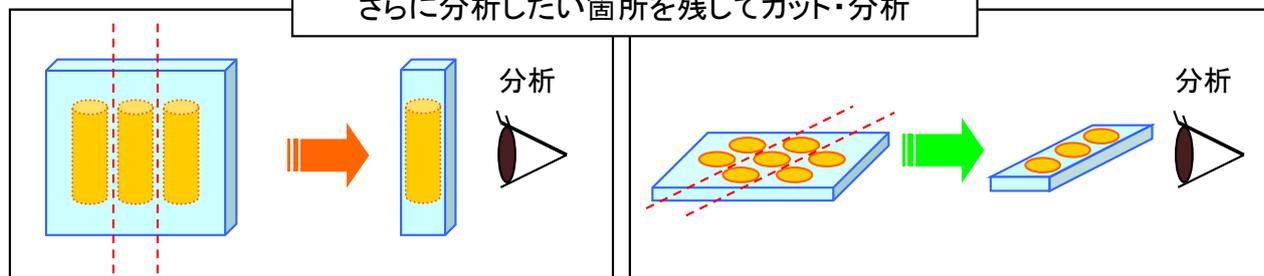
ウエハ・チップを割らずに小片を抜き出して薄片化し、高分解能TEM観察・分析を行います。さらに分析したい箇所を残してカットしてサンプルを作製することで、目的箇所をご要望のあらゆる方向からTEM観察・分析し、データをご提供します。高度なTEMサンプル作製技術を通じて、様々な観察・分析・評価ニーズにお応えします。

データ

■ 高度なTEMサンプル作製技術

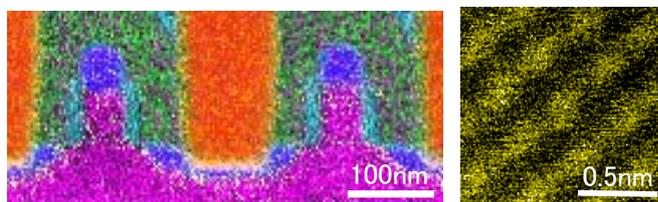


さらに分析したい箇所を残してカット・分析



■ 様々な観察・分析・評価ニーズにお応えします

球面収差補正機能(Csコレクタ)付きSTEM

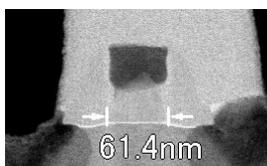


高感度/高分解能EDX・EELS分析を行います。

SiデバイスのEDX元素マッピング(左)

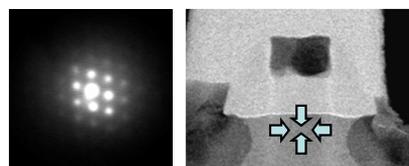
Si-Lエッジの格子分解EELSマッピング(右)

Image Measuring Tool



専用測長ソフトでTEM像での寸法計測を行います。

NBD (Nano Beam Diffraction)



局所領域の構造解析を行います。

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>